

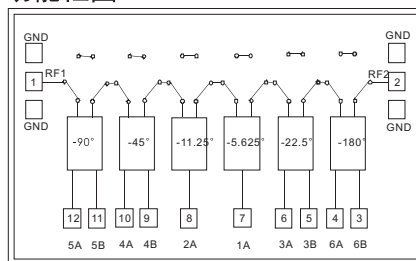
BW327

GaAs单片集成6位数控移相器

性能特点

- 工作频段：0.8~2GHz
- 插入损耗：11dB
- 移相精度（RMS）：2.5°
- 插损波动：±0.5dB
- 芯片尺寸：5.60x3.60x0.10mm

功能框图



概述

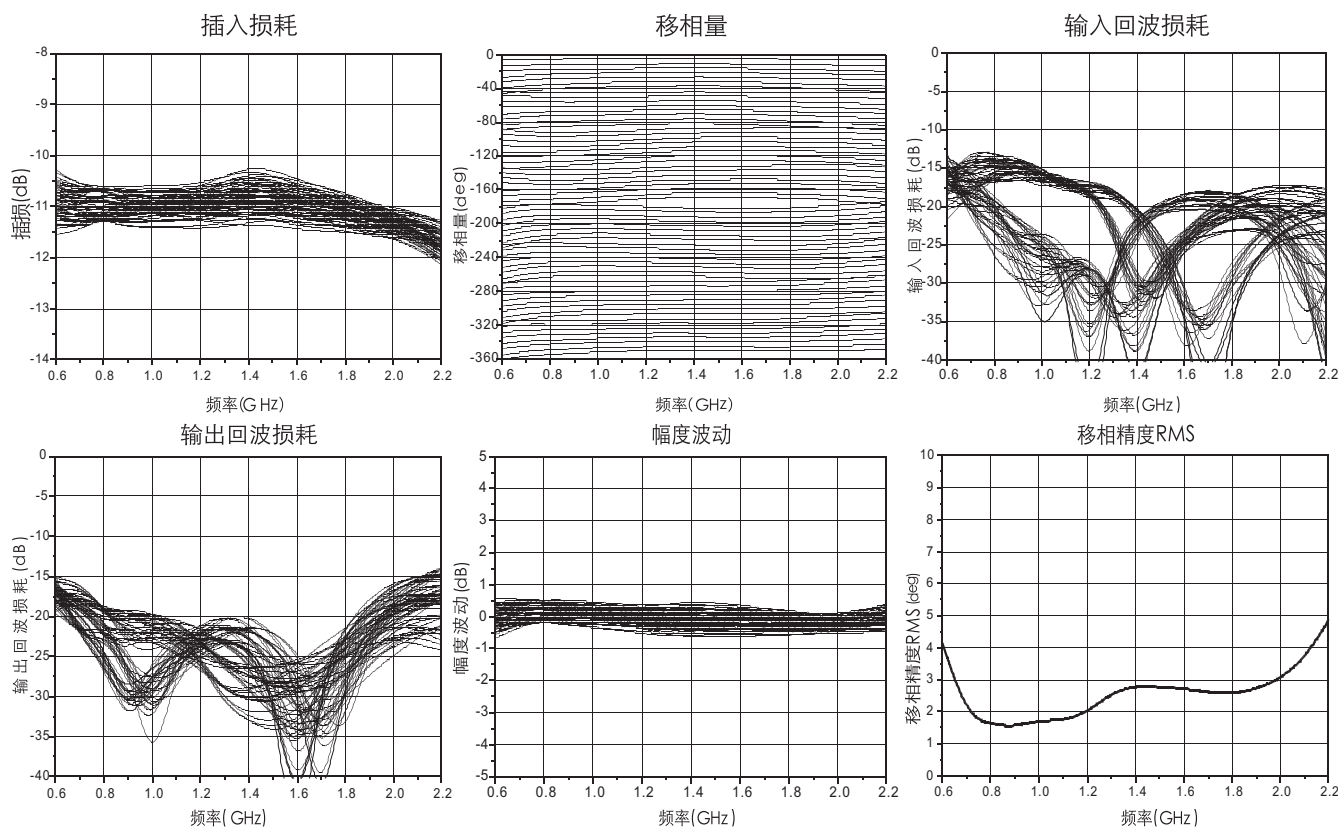
BW327是一款GaAs 6位数控移相器芯片。工作频率0.8-2GHz，插入损耗小于12 dB，基本移相位为-5.625°、-11.25°、-22.5°、-45°、-90°、-180°，总移相量-354.375°。该芯片采用0/-5V逻辑控制，不需要外接电源偏置，没有功率消耗。在整个工作频率范围内具有优良的移相精度和端口驻波特性和，非常适合应用于微波混合集成电路和多芯片模块以及低功耗系统。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好接地,不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

电性能表 (T_A =+25℃, 0/-5V控制, 50Ω system)

参数	频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	0.8~2GHz	-	11	12	dB
插损幅度波动	0.8~2GHz	-	±0.5	±1	dB
移相精度（RMS）	0.8~2GHz	-	2.5	3	deg
回波损耗（RF1、RF2）	0.8~2GHz	-	15	12	dB
输入P1dB	0.8~2GHz	-	21	-	dBm
输入IP3	0.8~2GHz	-	35	-	dBm
开关时间	-	-	10	-	ns

测试曲线(射频端口使用两根Φ25um长400um键合线)



BW327型GaAs单片集成6位数控移相器

极限参数

射频输入功率	+24dBm
控制电压范围(A , B)	+0.5 V ~ -7.0V
结 温	175 ℃
储存温度	-65~+150 ℃
工作温度	-55~+125 ℃
静电防护等级 (HBM)	Class1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

键合压点定义

压点 编号	功能 符号	功能描述
1,2	RF1, RF2	RF端口, 阻抗50ohm, 射频 通路不是0V, 需外接隔直电容
4,6,7, 8,10,12	CTRL A	控制端口
3,5,9,11	CTRL B	控制端口
-	GND	芯片背面必须接地

控制电压

状态	偏置条件
低(0)	0 ~ -0.2V
高(1)	-3 ~ -5V

真值表

-5.625°	-11.25°	-22.5°	-45°	-90°	-180°	移相 状态
1A	2A	3A 3B	4A 4B	5A 5B	6A 6B	
1	1	1 0	1 0	1 0	1 0	参考态
0	1	1 0	1 0	1 0	1 0	-5.625°
1	0	1 0	1 0	1 0	1 0	-11.25°
1	1	0 1	1 0	1 0	1 0	-22.5°
1	1	1 0	0 1	1 0	1 0	-45°
1	1	1 0	1 0	0 1	1 0	-90°
1	1	1 0	1 0	1 0	0 1	-180°

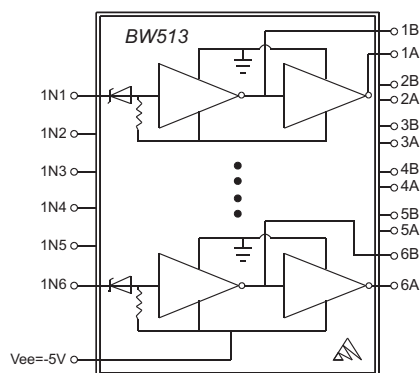
外形尺寸



说明:

1. 单位: 微米
2. 芯片背面镀金
3. 芯片背面接地
4. 键合压点镀金, 1,2压点尺寸: 150×100(um); 3-12:100×100(um)
5. 不能在通孔上进行键合
6. 外形尺寸公差: ±50um

推荐驱动电路



备注: BW513是单片集成6位FET驱动器。

应用信息

- 装配图(射频端口使用两根Φ25um长300um的键合线)

